

公益社団法人 応用物理学会



先進パワー半導体分科会 チュートリアル

◇ 日時:2016年11月7日(月)10:00~18:00◇ 会場:つくば国際会議場1階大会議室101+102

(アクセス情報 https://www.epochal.or.jp/)

◇ 定員:150名

先進パワー半導体分科会第3回講演会(2016年11月8、9日)に先立ちまして、チュートリアルを開催します。パワー半導体を研究している大学院生や若手研究者を主な対象とし、一流の講師陣からパワーエレクトロニクスおよびSi・SiC・GaN パワー半導体の基礎についてご講演いただきます。

[世話人幹事] 久本 大(日立)、児島 一聡(産総研)、四戸 孝(東芝)

1. 10:00~11:00 **パワーエレクトロニクスの基礎** (大阪大学 舟木 剛)

2. 11:10~12:10 **Si パワーデバイスの基礎** (筑波大学 岩室 憲幸)

3. 13:30~14:30 **SiC パワーデバイスの基礎** (京都大学 木本 恒暢)

4. 14:40~15:40 GaN パワーデバイスの基礎 (名古屋大学 加地 徹)

5. 15:50~16:50 **MOS 界面評価技術の基礎** (東京大学 喜多 浩之)

6. 17:00~18:00 パワーデバイスの品質·信頼性確保の基礎 (富士電機 山口 浩二)

■参加申込方法:

先進パワー半導体分科会第3回講演会ウェブサイト(http://annex.jsap.or.jp/adps/scrm/)にあるオンライン申込ページから締め切り日(10月21日(金)17:00)までにウェブ決済を完了して下さい。ただし、定員に達し次第、締め切らせていただきます。なお、席に余裕がある場合のみ、締め切り日以降も受付いたします。

■参加費:

先進パワー半導体分科会会員※3000円、一般6000円

先進パワー半導体分科会学生会会員 1000円、学生一般 2000円

下記は締め切り日以降の参加費です。ただし、席がある場合のみ受け付けます。(問い合わせは東芝・四戸まで)

先進パワー半導体分科会会員※ 5000円、一般 8000円

先進パワー半導体分科会学生会会員 3000円、学生一般 4000円

**先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■問合せ先:

四戸 孝(東芝)TEL: 044-549-2142, E-mail: takashi.shinohe@toshiba.co.jp 岡山 昇平(応用物理学会 事務局)TEL: 03-5802-0863, E-mail: divisions@jsap.or.jp